Облікова картка ДіР

Image not found or type unknow

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0203U006656

Державний реєстраційний номер: 0100U002859

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 03-06-2003

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Дослідження електронно-молекулярних явищ на поверхні напівпровідникових шарів і розробка наукових основ фізико-хімічних процесів у напівпровідникових сенсорах

Початок етапу: 01.2000

Закінчення етапу: 12.2002

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова

Код за ЄДРПОУ: 02071091

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 23-84-17

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України "Київський Політехнічний Інститут"

Код за ЄДРПОУ: 00027677

Місцезнаходження: пр. Перемоги 37, м. Київ, Київ, 03056, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 0442048428

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування:

Джерела фінансування

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Дослідження електронно-молекулярних явищ на поверхні напівпровідникових шарів і розробка наукових основ фізико-хімічних процесів у напівпровідникових сенсорах

Назва роботи англійською:

The ivestagation of electron-molecular phenomena on the semiconductor layers surfaces and elaboration of scientific basis for the the physico-chemical processes in the semiconductor sensors

Реферат українською:

Створено теретичну модель електронно-молекулярних процесів на поверхні напівпровідникових плівок з урахуванням регібридизації поверхневих атомів. Експеременталько досліджувана електронна структура хемосорбованих комплексів н а поверхні тонких плівок двоокису олова, сульфіду і селеніду кадмію і поруватого кремнію. Отримано залежності адсорбційної чутливості від хімічного складу, структури поверхні і електронних параметрів напівпровідника

Реферат англійською:

The theoretical model of electronic-molecular processes on surface of semiconducror films with the registration rehybridization of surface atoms is generated. Electronic structure of chemocomplexes on surface of thin films of tin oxide, sulphide and selenide of cadmium and porous silicom is explored experimentally. The associtions of adsoption sensitivity onchemical cjmposition, surface texture and electronic parameters of a semiconductor are receivedr

Індекс УДК: 621.315.592, 621.315.592

Коди тематичних рубрик: 47.09.29

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Сминтина В.А.

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис

1. Вашпанов Ю.А., Смытнына В.А. Адсобционная чувствительность пористого кремния Обзор// Вісник Одеського університету. Сервя"Фізикою.матем. науки" 2001, т. 6, вип3.-С. 114-132.2. Ваксман Ю.Ф. Вашпанов Ю.А Ницук Ю.А., Пуртов Ю.Н., Шапкин П.В. Механизмы рассеяния электронов в кристаллах селенида цинка, легированных индием// Вісник ОДУ, сер. "фіз.-мат. науки, 2000.-т. 5.-вип. 3.-С. 44-48.3. Vashpanov Yu. A. Smyntyna V.A. Study of degradation mechanism of adsorption sensitinity and increase of stability of oxygen microelectronic sensors// Photoelecrtonics, 2001.-n.. 10.- P.75-77.4.. A.P. Chebanenko V.S. grinevich ,L.N. Phylevskaya. The optimization methods for the electrooptic parameters of the Zn S transdusers// photoelectronics.-2001, №10. P. 66-68.5. V. Golovanoc, V.. Smyntyna, V. Brinzari. G. Korotecenkov. CxS-and Snx

WOu-based cas sensors; the role of chemical cjmposition ib CO sensing// Photoelectronics 2001, №10 ,P 6-11. 6. V. Golovanow, T.T rantala, T.S. Rantala V. Lantto. Rehybridization at (110) f

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Сминтина В.А.

Перелік осіб-виконавців

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

